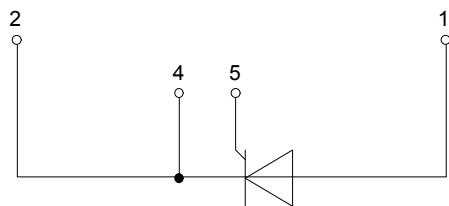
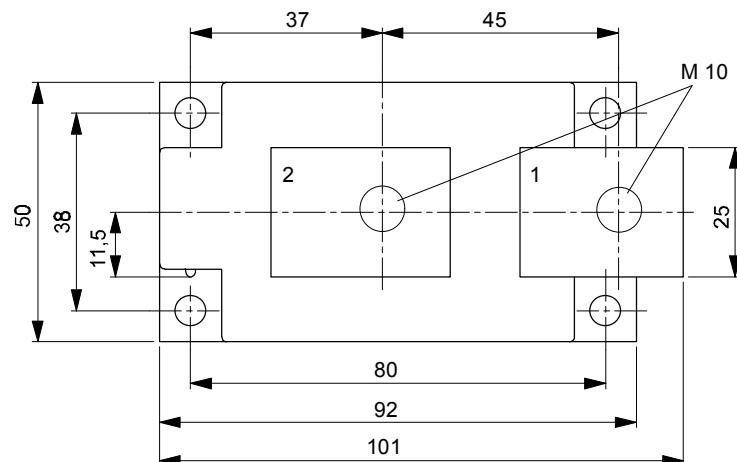
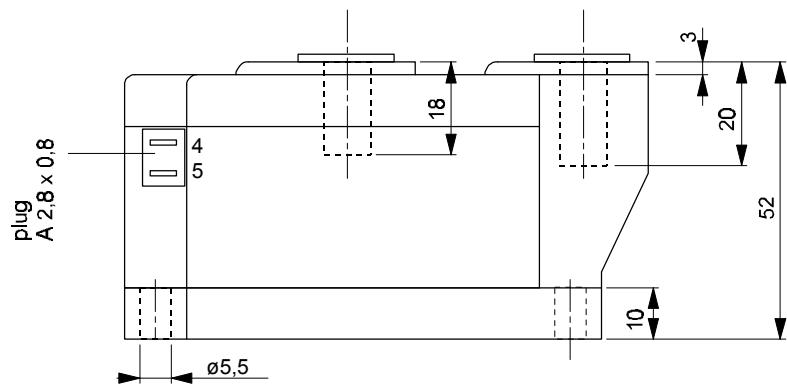


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information TZ 425 N



TZ 425 N

Elektrische Eigenschaften					
Höchstzulässige Werte					
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = t_{vj\ op}$	V_{DRM}, V_{RRM}	600...1800	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	$t_c = 85^\circ C$	I_{TRMSM}	800	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 74^\circ C$	I_{TAVM}	425	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 45^\circ C, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{TSM}	510	A
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	14,5	KA
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$t_{vj} = 45^\circ C, t_p = 10 \text{ ms}$		12,5	KA
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	$1051 \cdot 10^3$	$A^2 s$
		DIN IEC 747-6, $f = 50 \text{ Hz}$, $v_L = 10 \text{ V}$, $I_{GM} = 1 \text{ A}$, $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	781 $\cdot 10^3$	$A^2 s$
		$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,67 V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	120	$A/\mu\text{s}$
		6.Kennbuchstabe/6th letter F		1000	$V/\mu\text{s}$
Charakteristische Werte					
Characteristic values					
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 1,5 \text{ kA}$	V_T	max. 1,5	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$	0,9	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	r_T	0,3	$m\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}	max.250	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max. 1,5	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}	max. 10	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max. -	mA
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$		max. 0,2	V
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	I_H	max.300	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6 \text{ V}, R_{GK} > = 10 \Omega$	I_L	max. 1500	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$	t_{gd}	max. 4	μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}, v_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_q	typ. 250	μs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	5.Kennbuchstabe/5th letter O RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min}$	V_{ISOL}	3	kV
Thermische Eigenschaften					
Innerer Wärmewiderstand	Thermal properties thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 180^\circ \sin R_{thJC}$		max. 0,0780	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Äußerer Wärmewiderstand	thermal resistance, case to ambient	pro Modul/per module, DC		max. 0,0745	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	R_{thCA}		-	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul.Sperrschiichttemperatur	max. junction temperature	pro Modul/per module	R_{thCH}	max. 0,02	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Betriebstemperatur	operating temperature	$t_{vj\ max}$		125	°C
Lagertemperatur	storage temperature	$t_{vj\ op}$		-40...+125	°C
t_{stg}				-40...+130	°C
Mechanisch e					
Gehäuse, siehe Seite	Mechanical properties case, see page				
Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation	internal insulation				AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	12	Nm
Gewicht	weight		G	typ. 900	g
Kriechstrecke	creepage distance			15	mm
Feuchteklassse	humidity classification	DIN 40040		-	
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$		5x9,81	m/s^2

TZ 425 N

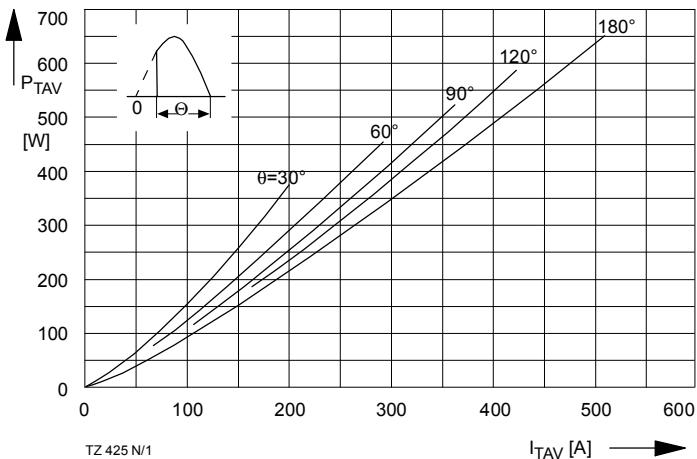


Bild / Fig. 1
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

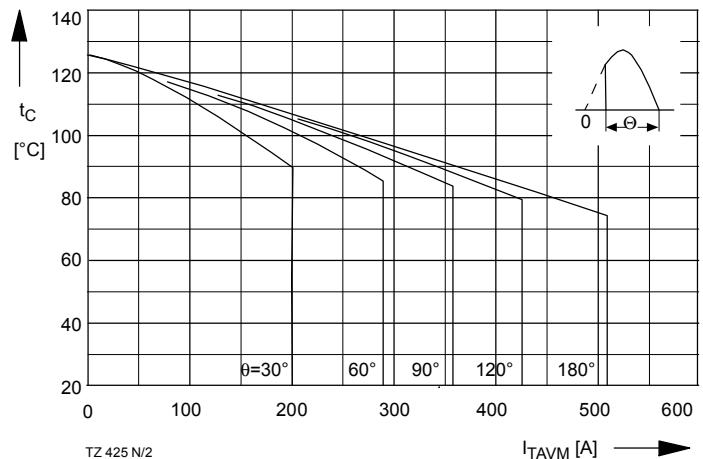


Bild / Fig. 2
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $t_C = f(I_{TAVM})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

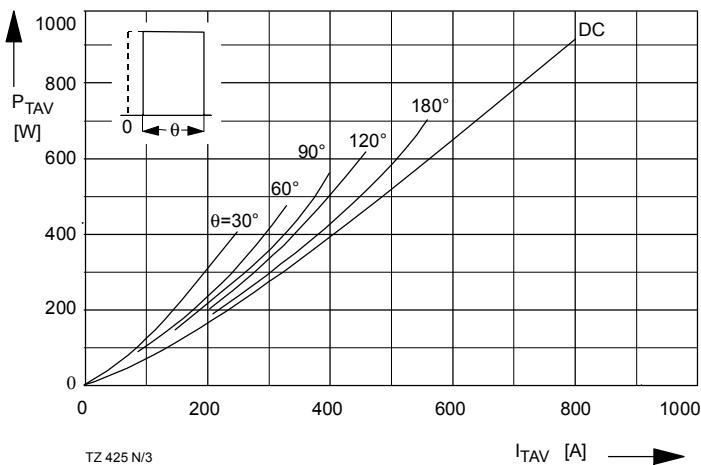


Bild / Fig. 3
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

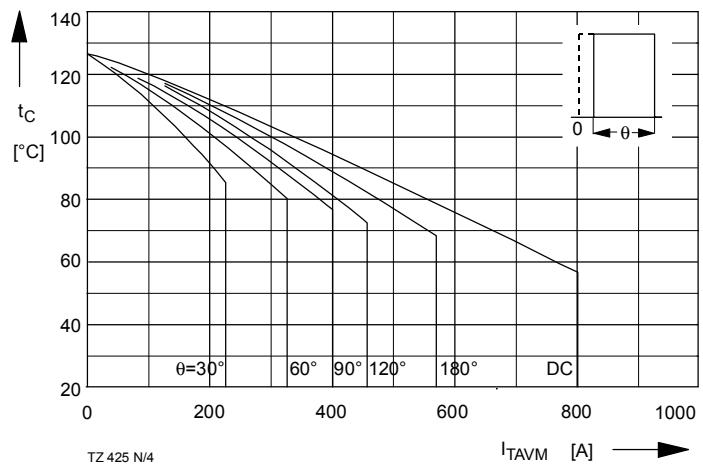


Bild / Fig. 4
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $t_C = f(I_{TAVM})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

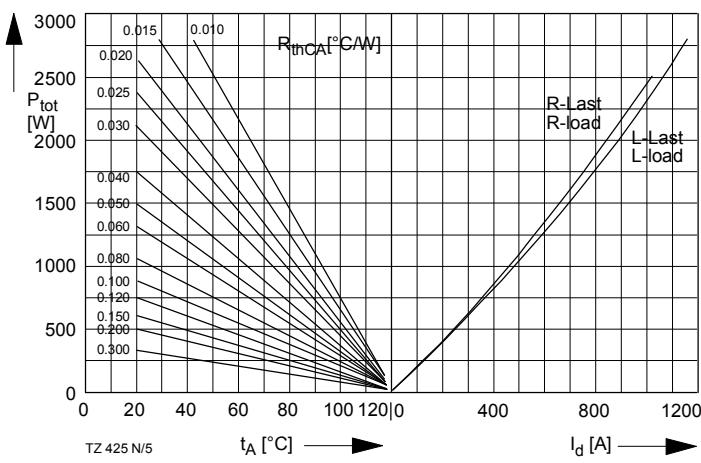


Bild / Fig. 5
B2 - Zweiplus-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung /
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

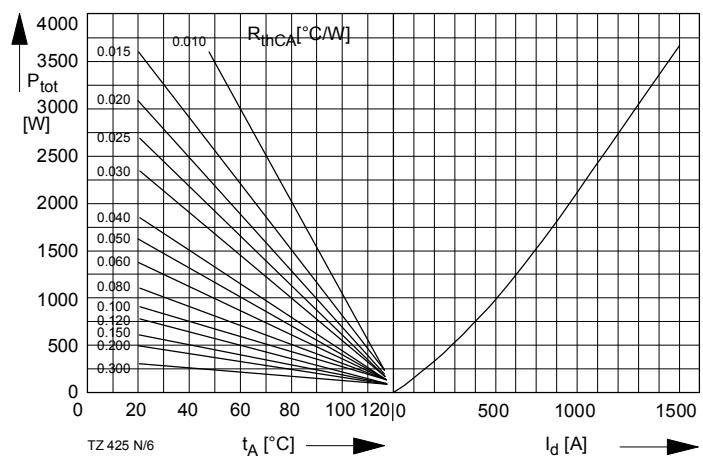


Bild / Fig. 6
B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung /
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

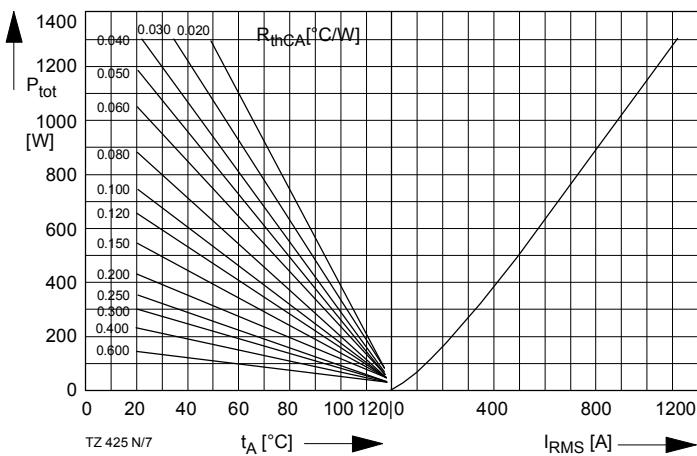


Bild / Fig. 7
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

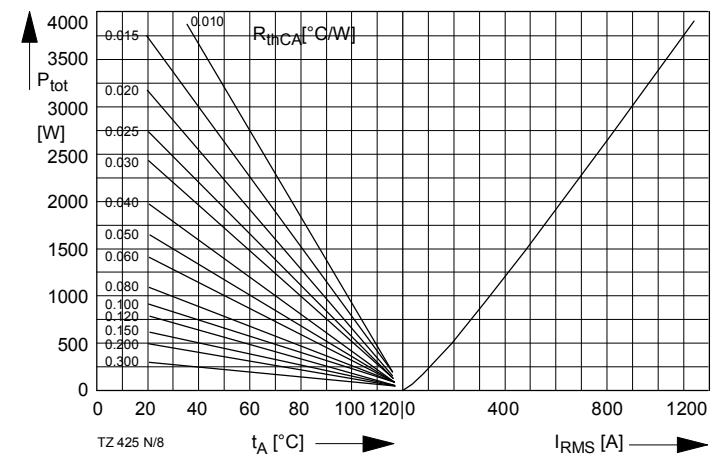


Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

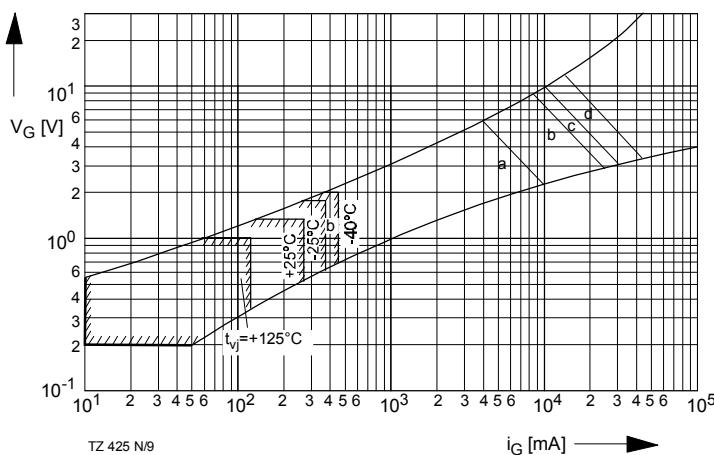


Bild / Fig. 9
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $V_G = f(i_G)$, $V_D = 6 \text{ V}$
Parameter:

	a	b	c	d
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_g [ms]	10	1	0,5	0,1
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/ Maximum allowable peak gate power [W]	40	80	100	150

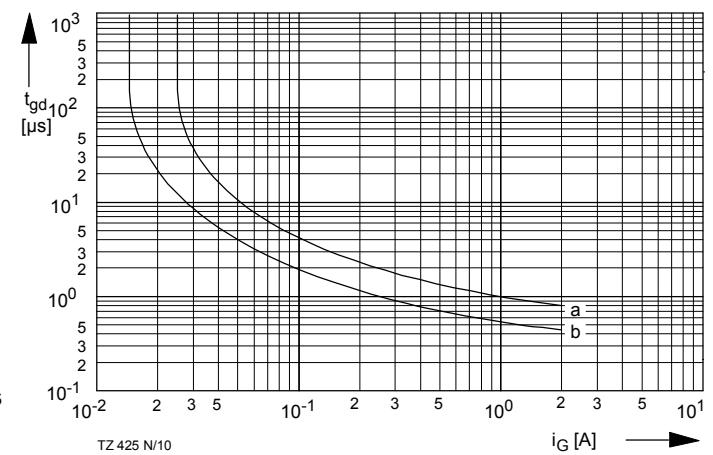


Bild / Fig. 10
Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$
 $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $\frac{di_G}{dt} = i_{GM}/1\mu\text{s}$
a - äußerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic

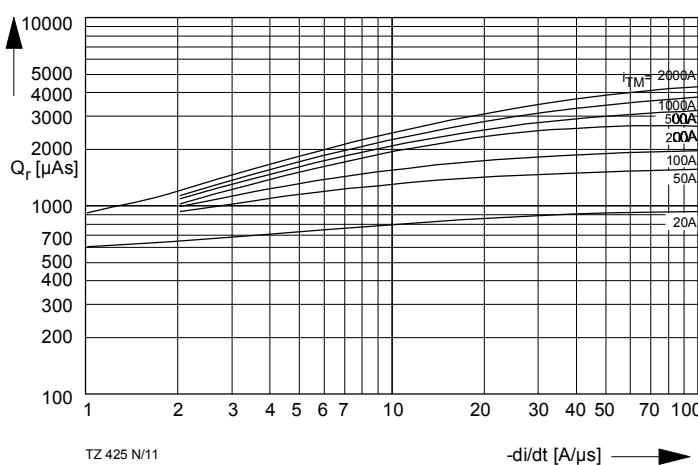


Bild / Fig. 11
Grenzstrom $I_{T(OV)M}$: Belastung aus Leerlauf, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$: Surge current under no-load conditions, $V_R = 0,8 V_{RRM}$
a - $t_A = 35^{\circ}\text{C}$, verstärkte Luftkühlung / forced cooling
b - $t_A = 45^{\circ}\text{C}$, Luftseltbstkühlung / natural cooling

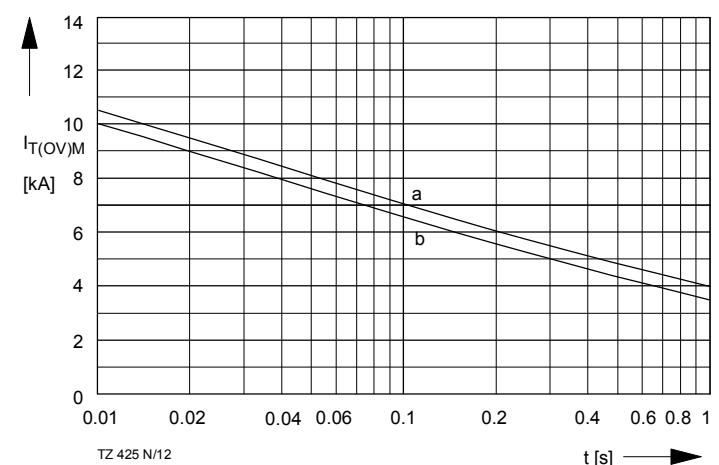
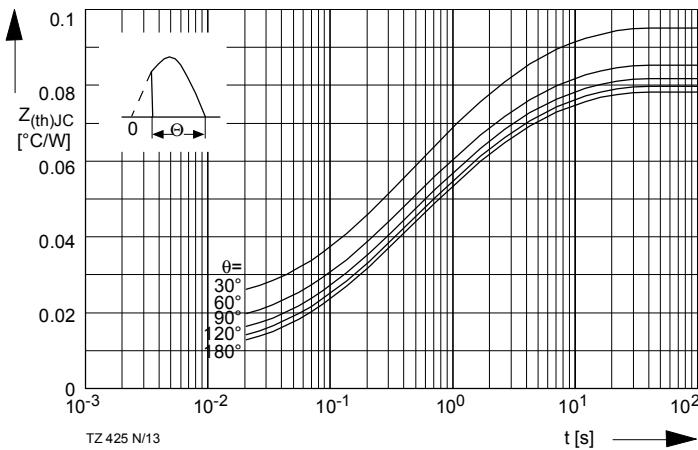


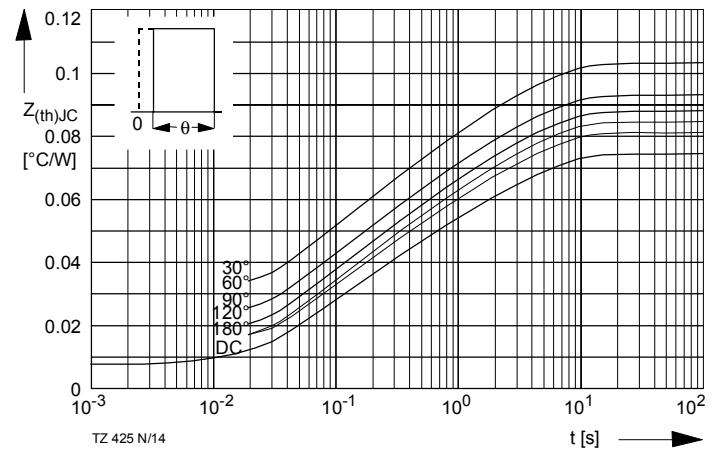
Bild / Fig. 12
Sperrverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj\max}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}



TZ 425 N/13

Bild / Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$



TZ 425 N/14

Bild / Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,00194	0,00584	0,01465	0,0254	0,0267		
τ_n [s]	0,000732	0,00824	0,108	0,57	3		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$